

Лазерные диоды для систем хранения данных

Лазерные диоды для DVD

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	Применение
ML1XX21	658	80 (в имп. 160)	Writeble DVD
ML1XX22*	658	90 (в имп. 180)	Writeble DVD
ML1XX23*	658	100 (в имп. 200)	Writeble DVD

* – новый прибор.

Лазерный диод для магнито-оптических систем

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	Применение
ML1XX10	685	50 (в имп. 60)	MO High Power

Лазерные диоды для CD-R/RW

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	Применение
ML6XX35	785	90 (в имп. 200)	CD-R/RW Low Operating Current
ML6XX37	785	90 (в имп. 200)	CD-R/RW Low Operating Current
ML6XX38	785	90 (в имп. 200)	CD-R/RW Low Operating Current

Лазерные диоды для оптических систем связи

FP лазерные диоды

Наименование	Длина волны, мкм	Мощность, мВт	Применение
ML7XX8	1,31	5	Diverse package including pin-connection, window cap
ML7XX35	1,31	5	~155 Mbps for FTTH application
ML7XX36*	1,31	13	High optical power LD for PON application
ML7XX19*	1,31	5	~2,5 Gbps, Ø5,6/ Ø3,8 мм CAN package
ML9XX6	1,55	5	Diverse package including pin-connection, window cap
ML9XX35	1,55	5	~155 Mbps for FTTH application

* – новый прибор.

DFB лазерные диоды

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	Применение
ML7XX11	1,31	5	~1 Gbps, 1275 1350 нм (25 нм spacing)
ML7XX16	1,31	5	2,5 Gbps, 20 85, λ/4 shifted structure
ML7XX28	1,31	5	10 Gbps, 20 70, λ/4 shifted structure
ML7XX32*	1,31	5	10 Gbps, 20 85, λ/4 shifted structure
ML9XX16	1,47/1,49	5	~1 Gbps, with S band for CWDM (8 channel)
ML9XX11	1,51/1,53/1,55	5	~1 Gbps, with C band for CWDM (8 channel)
ML9XX22	1,57/1,59/1,61	5	~1 Gbps, with L band for CWDM (8 channel)
ML9xx19*	1,47 1,61	5	2,5 Gbps, 0→+70, λ/4 shifted structure, for CWDM (8 channel)
ML9xx40	1,55	5	2,5 Gbps, 0→+85, λ/4 shifted structure, for CWDM (8 channel)

* – новый прибор.

Лазерные диоды высокой мощности

Наименование	Длина волны, мкм	Мощность, мВт	Применение
ML9XX8	1,48	150	Ø10,5 mm CAN package
ML9XX25	1,48	200	High optical power, Ø10,5 mm CAN package
ML8XX2*	0,98	200	0–70 °C (uncooled), Ø5,6 mm CAN package, Rf<1%
ML8XX4*	0,98	200	0–70 °C (uncooled), Ø5,6 mm CAN package, Rf~4%
ML8XX7	0,98	200	0–70 °C (uncooled), Ø5,6 mm CAN package, Rf~4%, wavelength stabilized type

* – новый прибор.

DFB лазерные диоды

Наименование	Длина волны, нм	Мощность, мВт	Применение
ML9XX11	1,53–1,56	10	2,5 Gbps, ~200 km reach, for C-band 47 channel
ML9XX22	1,56–1,61	10	2,5 Gbps, ~200 km reach, for L-band 58 channel
ML9XX17	1,53–1,56	5	2,5 Gbps, ~700 km reach, EML for C-band 46 channel
ML9XX31*	1,53–1,56	5	10 Gbps, ~50 km reach, EML for C-band 46 channel
ML9xx37	1,55	60	High power CW source for 40 Gbps
ML9xx38			EAM for 40 Gbps, Ultra high speed response, high extension ratio

* – новый прибор.

Лазерные диоды высокой мощности

Наименование	Длина волны, мкм	Мощность, мВт	Применение
ML7XX10	1,31	300	Ø 5,6 mm CAN package
ML9XX10	1,55	200	Ø 5,6 mm CAN package

Фотодиоды для оптических систем связи

Наименование	Диаметр, мкм	Структура	Применение
PD7XX8	Ø 80 мкм	PIN	~1 Gbps, TO-56 with ball lens, flat glass
PD7XX7	Ø 40 мкм	PIN	2,5Gbps, diverse package
PD7XX13	Ø 20 мкм	PIN + TIA	2,5 Gbps, PD with Pre-amplifier, TO-CAN
PD7XX26	Ø 20 мкм	PIN	10 Gbps, chip on carrier
PD8XX2	Ø 50 мкм	APD	~1 Gbps, TO-56/chip on carrier
PD8XX3	Ø 35 мкм	APD	2,5 Gbps, TO-56/chip on carrier
PD8XX4	Ø 35 мкм	APD TIA	2,5 Gbps, APD with Pre-amplifier, TO-CAN
PD8XX6	Ø 20 мкм	APD	10 Gbps APD, chip on carrier